Hynebru. Kegena 4

22–28 сен. 4 Энергия и силы в электрич ском поле. Токи в неограниченных ср	04.2	T1' 1.5 3.44 3.67/68 4.36	T5 3.73 T6 4.23
--	------	---------------------------	--------------------------

5 4.1°

°4.1. Поверхностная плотность заряда на пластинах плоского конденсатора, заполненного твёрдым диэлектриком с проницаемостью ε , равна $\pm \sigma$. Определите объёмную плотность электрической энергии w в конденсаторе, а также силу f, действующую на единицу площади обкладок.

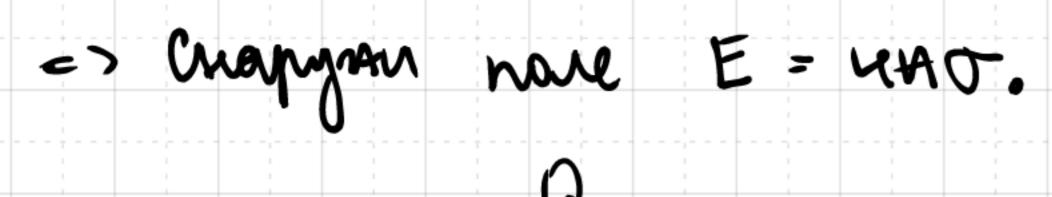
Other:
$$w = \frac{2\pi\sigma^2}{\varepsilon}$$
, $f = 2\pi\sigma^2$.

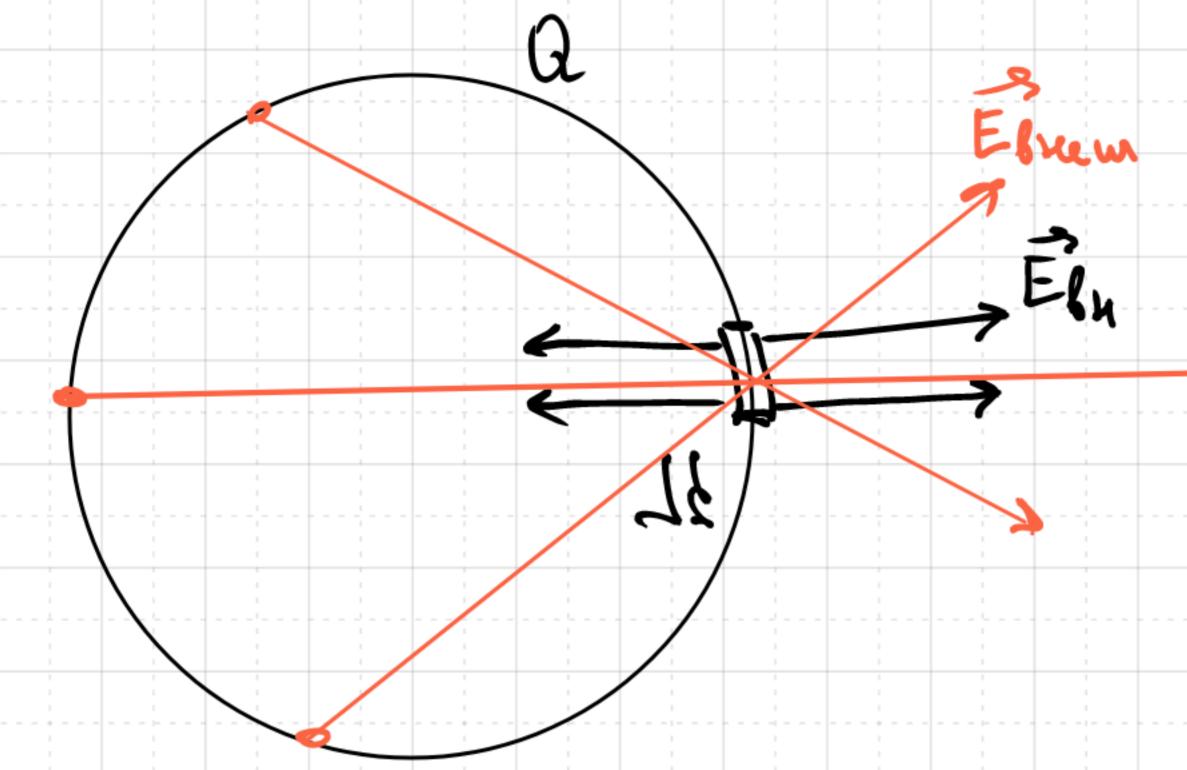
Bano.	Penetuu:	
E, ±0	W= TT = OU' = OU' E S	$\frac{1}{4}\left(\frac{u}{a}\right)^{2} = \frac{\epsilon}{1}$
W, 5 = 1	D' (410) 240°	
	8t1 E 8t1 E	
$f = \frac{1}{5}$		
()mbm		

53.50

3.50. По сфере радиусом R равномерно распределен заряд Q. Определить давление изнутри на поверхности сферы, обусловленное взаимодействием зарядов.

Damo:	Pemenne:	
R, Q		Brynipu rpobognung copym/japegob
	E=0	net => no meopure gapages nore bujtper
F = 7		nero pabrio nyrivo.
		T.n. DEn = 4H (=)





Hore E eoggaenics

noncu Ep, = 200 n° sapegos,

porenoso perintir na moyague Is

u noncu napyonux japegos Ebrewa

sapegos, peenosohenunx bu moyaguu.

Touge $f = \frac{F}{4S} = \frac{OdS \cdot Elnew}{dS} = \frac{2\pi O'}{2\pi O'} = \frac{2\pi O'}{4\pi R'} = \frac{O'}{8\pi R'}$ Ombern: $f = \frac{O'}{8\pi R'}$ QE

N4.2°

 0 4.2. Конденсатор ёмкостью C=20 см заполнен однородной слабопроводящей средой, имеющей малую проводимость $\lambda=10^{-6}~\mathrm{Om^{-1}\cdot cm^{-1}}$ и диэлектрическую проницаемость $\varepsilon=2$. Определить электрическое сопротивление между обкладками.

<u>Ответ:</u> 8 кОм.

Domo: Pernemu: C = 20 em $\lambda = 10^6 \Omega u^{-1} \text{ em}^{-1}$ $\lambda = 10^6 \Omega u^{-1} \text{ em}^{-1}$

2 8 k Ou

Omben: 8 k Ou